



# Dilase 750

## Estación de Litografía Directa por Láser de Alto Rendimiento

- ▶ Un sistema avanzado de muy alta resolución
- ▶ Flexible y completamente personalizable
- ▶ Hasta tres láseres: 266nm, 325nm, 375nm, 405nm o 445nm
- ▶ Compatible con todas las resinas
- ▶ Relación de aspecto muy alta: 1:50
- ▶ Rápido prototipaje y fabricación de máscaras
- ▶ Gran área de escritura



# Dilase 750

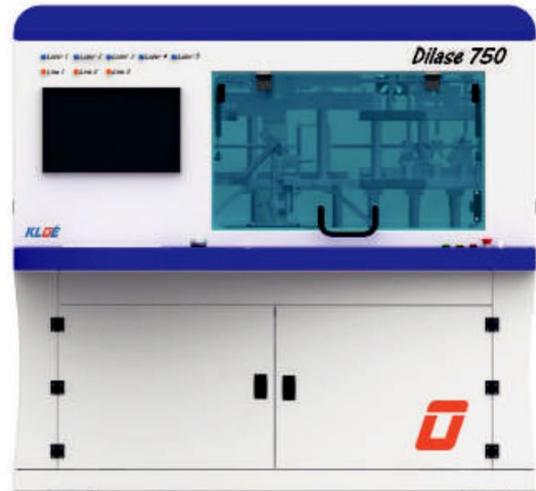
Dilase 750 es una completa estación de Litografía Directa por Láser de Alta Resolución y Rendimiento.

Permite instalar hasta tres láseres de diferentes longitudes de onda (266 nm, 325 nm, 375 nm, 405 nm o 445 nm). La superficie de exposición se puede extender hasta 12", con una desviación de trayectoria máxima estándar de 100 nm. Las diferentes líneas ópticas ofrecen varias opciones de tamaño de haz, con un tamaño mínimo inferior a 500 nm.

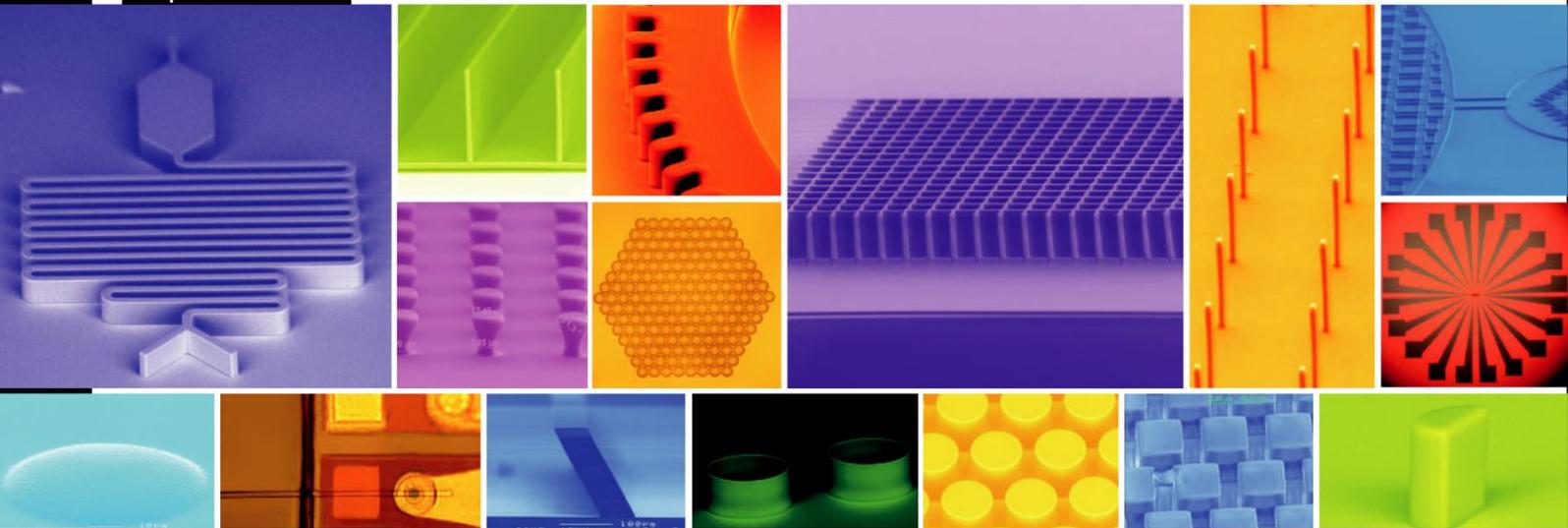
Este sistema de alto rendimiento está fabricado totalmente a medida, para adaptarse a las necesidades específicas de fabricación o prototipado de los investigadores. El Dilase 750 es compatible con todas las resinas existentes en el mercado, como las resinas SU8, Shipley y AZ. Usando la resina K-CL desarrollada por Kloé es posible conseguir relaciones de aspecto superiores a 1:50; esto lo convierte en un sistema muy atractivo para aplicaciones como microfluídica o fabricación de dispositivos.

## Características

- Tamaño: 1801 x 1204 x 1790 mm
- Interfaces de control informático integradas
- 1 o 3 láseres: 266, 325, 375, 405 or 445 nm
- 1 a 3 líneas ópticas con cambio automático
- Sistema de posicionamiento de video de alta resolución
- Soporte de formato de datos : LWI (Formato del Software de Kloé), DXF, GDS2
- Configuración de enfoque automático
- Software de diseño integrado: Design Kloé V.2
- 3 modos de escritura: vectorial, scanning o una combinación de ambos.



## Aplicaciones



## Especificaciones

Velocidad de escritura lineal	> 350 mm.s-1
Resolución stage	40 nm - 100 nm
Repetibilidad	100 nm
Área de escritura	5 mm a 12"
Grosor del sustrato	250 µm a 10 mm
Tamaño del haz	0.5 µm to 100 µm
Factor de forma	Mínimo 10
Precisión de realineación	500 nm